2SC2926
2SC2926S

エピタキシャルプレーナ形NPNシリコントランジスタ
高周波増幅用／RF Amplifier
Epitaxial Planar NPN Silicon Transistor

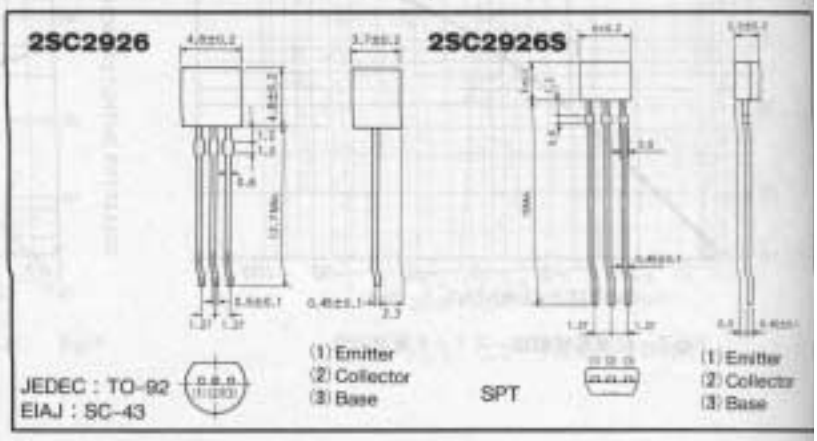
● 特長

1) f_T=1.1GHz Typ. (at 10mA) と高い。
2) $C_c \cdot r_{bb'}$ が少なく高利得である。
3) 雑音特性がよい。

● Features

1) High transition frequency: f_T=1.1GHz (at 10mA)
2) Low base resistance and high gain.
3) Excellent noise response.

● 外形寸法図／Dimensions (Unit : mm)



● 絶対最大定格／Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	30	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	19	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	4	V
コレクタ電流	I_C	50	mA
コレクタ損失	P_C	300	mW
接合部温度	Tj	125	℃
保存温度	Tstg	−55～125	℃

● 電気的特性／Electrical Characteristics (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CEO}	19	—	—	V	I_C=1mA
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CBO}	30	—	—	V	I_C=50μA
エミッタ・ベース降伏電圧	BV_{EBO}	4	—	—	V	I_E=50μA
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	—	—	0.5	μA	V_{CB}=20V
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	—	—	0.5	μA	V_{EB}=3V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	0.1	—	V	I_C/I_B=10mA/1mA
直流電流増幅率	h_{FE}	39	—	270	—	V_{CE}/I_C=10V/5mA
利得帯域幅積（トランジション周波数）	f_T	600	1100	—	MHz	V_{CE}=5V, I_C=10mA
出力容量	C_{ob}	—	1.2	1.5	pF	V_{CB}=10V, f=1MHz
コレクタ・ベース時定数	$C_C \cdot r_{bb'}$	—	10	15	pS	I_C=10mA, V_{CB}=5V, f=31.8MHz

h_{FE}の値により下表のように分類します。

Item	M	N	P	Q
h_{FE}	39～82	56～120	82～180	120～270

標準品・準標準品一覧表　（◎：標準品　○：準標準品）

Type	h_{FE}	包装名	バルク	テーピング			
		記号		T91	T92	T93	TP
		基本発注単位(個)	1 000	1 500	1 500	3 000	2 500
2SC2926	MNPQ		◎	◎	◎	◎	−
2SC2926S	MNPQ		○	−	−	−	○